



ПОЛЮС БАС

Установка осаждения MR SEMI 200 PECVDS

**Техническая
информация**

Установка осаждения MR SEMI 200 PECVDS



Применение: научно-исследовательские работы и небольшое серийное производство

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стандартная конфигурация	MR SEMI 200 PECVDS
Реакционный источник	Силан / TEOS
Тип камеры	Загрузка 1 пластины
Процессы	PECVD, SACVD
Диаметр пластин	2", 3", 4", 5", 6", 8"
Платформа	Ручная загрузка
Генератор плазмы	13,56 МГц, 2000 Вт или 350 кГц, 900 Вт
Нагрев пластины	Макс. температура 400°C (550°C для SA)

ПОЛЮС БАС

☎ +7 (499) 444-70-45

✉ info@polusbас.ru 🌐 www.polusbас.ru